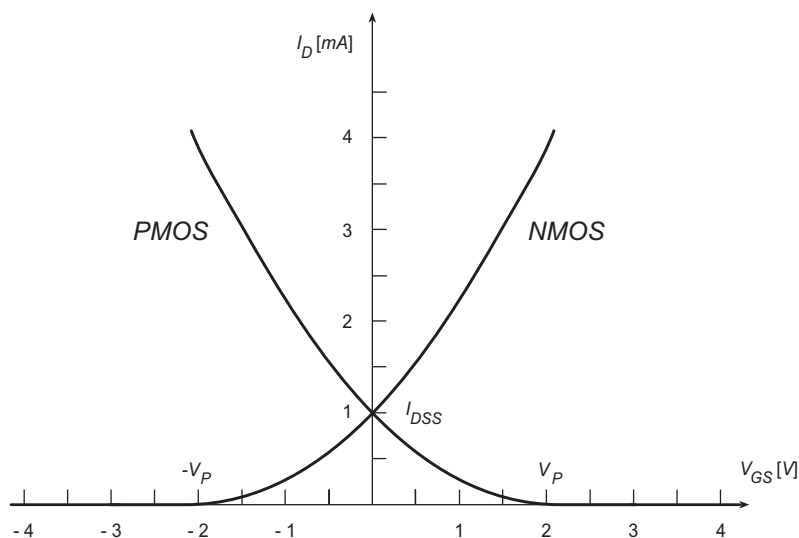
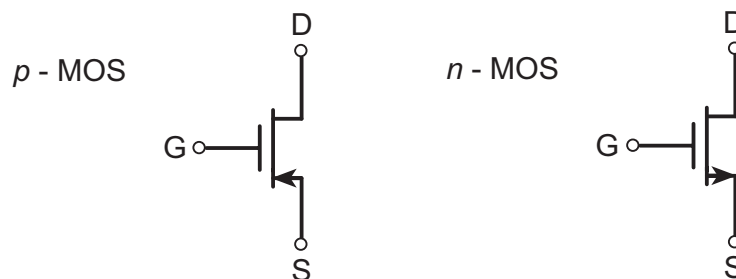


Struttura fisica di un transistor NMOS a svuotamento. Il canale è stabilmente impiantato nella regione sottostante il *gate*. In questa maniera all'applicazione di una tensione V_{DS} al dispositivo, anche per $V_{GS} = 0$ il canale risulta attraversato da una corrente I_D , denominata I_{DSS} . Se V_{GS} è sufficientemente negativa, il canale scompare e si interrompe il flusso di corrente tra il *drain* e il *source*. La tensione V_{GS} in corrispondenza delle quale ciò avviene prende il nome di tensione di *pinch-off* V_P .



Caratteristiche $I_D - V_{GS}$ per transistor MOSFET a svuotamento di tipo n e di tipo p in saturazione ($I_{DSS} = 1 \text{ mA}$, $V_P = 2 \text{ V}$).



Simboli per i MOSFET a svuotamento a canale n (a destra) e a canale p (a sinistra). La freccia identifica il morsetto di *source* e il verso positivo della corrente I_D .